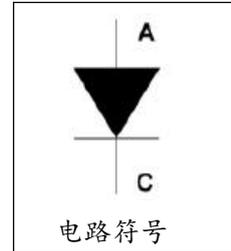


## KD960

### 特点:

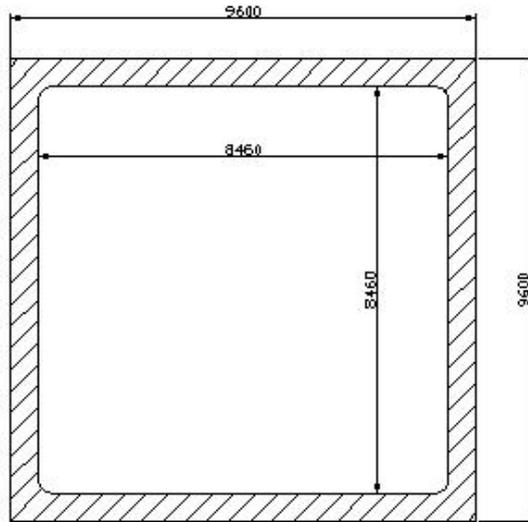
- 阻断电压高 (>2000V)
- 低正向压降; 高通态电流  $I_F$
- 复合钝化台面结构芯片, 高温漏电小, 可靠性高



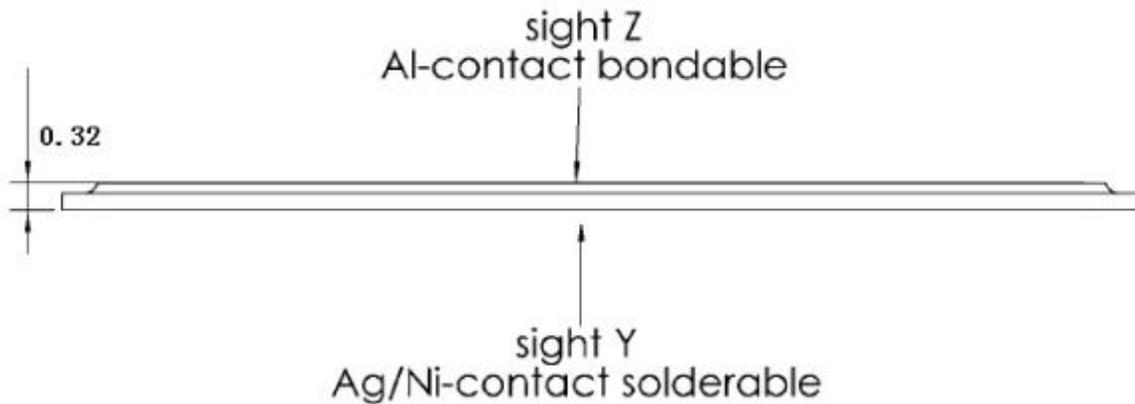
### 应用:

主要应用于各类电力电子模块等。

### 外形尺寸图:



单位: 微米



单位: 毫米



## 极限值

参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
$V_{RRM}$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$ , $I_R=0.1\text{mA}$			2000	V
$I^2t$	$T_j=125$ , $t=10\text{ms}$ , $\sin 180^{\circ}$	-	-	11600	$\text{A}^2\text{S}$
$I_{F(AV)}$	$T_s=80^{\circ}\text{C}$ , $T_j=125^{\circ}\text{C}$			120	A
$I_{F(DC)}$	$T_s=80^{\circ}\text{C}$ , $T_j=125^{\circ}\text{C}$			150	A
$I_{FSM}$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$ , $t=10\text{ms}$ , $\sin 180^{\circ}$			1800	A
	$T_j=125^{\circ}\text{C}$ , $t=10\text{ms}$ , $\sin 180^{\circ}$			1500	
$T_j$		-		150	$^{\circ}\text{C}$

## 电特性

参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
$I_{RRM}$	$V_{RRM}$ , $T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	-	0.1	mA
	$V_{RRM}$ , $T_j=125^{\circ}\text{C}$	-	-	2.2	
$V_F$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$ , $I_F=84\text{A}$	-	-	1.21	V
	$T_j=125^{\circ}\text{C}$ , $I_F=84\text{A}$			1.1	V
$V_{(TO)}$	$T_j=125^{\circ}\text{C}$	-	-	0.85	V
$R_T$	$T_j=125^{\circ}\text{C}$	-		1.6	m $\Omega$
$T_{rr}$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$ , $\pm 1\text{A}$	-	30	400	$\mu\text{S}$